

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

1. 概述

JD3561 是一款针对离线式反激电源设计的高性能功率开关。

JD3561 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能,可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。

JD3561集成有完备的保护功能,包括: VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。

2. 特点

- 集成高压 MOSFET
- ±1%恒压精度
- 待机功耗<75mW
- 固定 65KHz 开关频率
- 绿色省电模式和打嗝模式工作
- 超低启动和工作电流
- 集成抖频功能优化 EMI
- 集成内部斜率补偿的电流模式控制
- 集成自恢复模式的保护功能:
 - VDD 欠压保护(UVLO)
 - VDD 过压保护 (OVP)
 - 过热保护(OTP)
 - 逐周期电流限制
 - 过载保护(OLP)
 - 前沿消隐(LEB)
 - CS 管脚开路保护



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

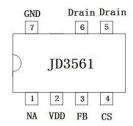
高度集成、离线式电流模式控制功率开关

3. 封装

3.1 管脚排列

DIP-7

型号	JD3561SA	JD3561DB	JD3561DD	JD3561DF	JD3561DG	
外形	SOP-7	DIP-7	DIP-7	DIP-7	DIP-7	
功率	5W	11W	14W	22W	26W	



3.2 管脚说明

管脚	名称	描述
1	NA	无功能管脚, 实际使用中悬空
2	VDD	芯片供电管脚
3	FB	反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压
4	CS	电流采样输入管脚
5,6	Drain	高压 MOSFET 漏极
7	GND	芯片参考地

4. 应用

4.1 范围

- 适配器电源
- 通用开关电源

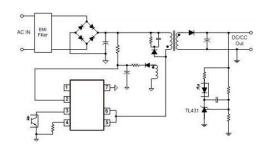


ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

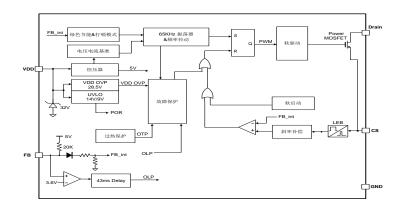
JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

4.2 典型应用线路



5. 功能框图



6. 电特性

6.1 极限参数(备注1)

参数	值	单位	
VDD 直流供电电压	30	V	
VDD 直流箝位电流	10	mA	
Drain 电压	-0.3 to 600	V	
FB, CS 电压	-0.3 to 7	V	
封装热阻结到环境 (DIP-7)	105	°C/W	
最大结温	175	°C	
储藏温度范围	-65 to 150	°C	
焊接温度 (焊接, 10 s)	260	°C	
ESD 人体模型	4	kV	
ESD 机器模型	500	V	

地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路中集创谷产业园 B 栋 1-3 层

电话: 0755-29799516 传真: 0755-29799515



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

6.2 推荐工作条件 (备注 2)

参数	值	单位	
VDD 供电电压	10 to 26	V	
工作环境温度	-40 to 85	°C	

6.3 电气参数 (TA=25℃, VDD=12V, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位		
供电部分(VDD 管脚)								
I _{VDD_st}	VDD 启动电流			2	20	uA		
I _{VDD_Op}	VDD 工作电流	V _{FB} =3V		1	1.8	mA		
I _{VDD_standby}	VDD 静态电流			0.6	1	mA		
V_{DD_ON}	VDD 开启电压		19	21	21.5	V		
V_{DD_OFF}	VDD 关断电压		8	9	10	V		
V_{DD_OVP}	VDD OVP 阈值		29	31	33	V		
V_{DD_Clamp}	VDD 箝位电压	I(V _{DD})=7 mA	33	35	37	V		
反馈部分(F	B管脚)							
V _{FB_Open}	FB 开路电压			5.9		V		
I _{FB_Short}	FB 短路电流			0.3		mA		
Z _{FB_IN}	FB 输入阻抗			20		ΚΩ		
A _{CS}	PWM 增益	$\Delta V_{FB}/\Delta V_{CS}$		2.0		V/V		
V_{skip}	驱动停止 FB 电压阈值			1.0		V		
V _{TH_OLP}	过流保护 FB 电压阈值			3.6		V		
T _{D_OLP}	过流保护延时时间			75		ms		
电流采样部分	电流采样部分(CS 管脚)							
T _{LEB}	前沿消隐			250		ns		
V _{cs(max)}	过流保护阈值		0.97	1.0	1.03	V		
T _{D_OC}	过流保护关断延时	GATE=1nF		70		ns		



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

振荡器部分								
Fosc	正常工作频率			60		65	70	KHz
ΔF(shuffle) /F _{OSC}	抖频范围			-4			4	%
T(shuffle)	抖频周期					32		ms
D _{MAX}	最大占空比					66.7		%
F _{Bust}	打嗝模式工作频率					22		KHz
过热保护部分								
T _{SD}	过热关断		备注3)			165		°C
T _{RC}	过热恢复		备注3)			140		°C
功率 MOSFET 部分(Drain 管脚)								
V_{BR}	功率 MOSFET 漏 源击穿电压			650)			V
		JD3	561SA			10		Ω
R _{dson}	直流导通阻抗	JD3	JD3561DB			4		Ω
		JD3	561DD			2		Ω
R _{dson}			561DF			1.4		Ω
	直流导通阻抗	JD3	561DG			1.2		Ω

备注1:超出列表中极限参数可能会对芯片造成永久性损坏。极限参数为额定应力值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,会影响器件的可靠性。

备注2:超出上述工作条件不能保证芯片正常工作。

备注3:参数取决于设计,批量生产制造时通过功能性测试。



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

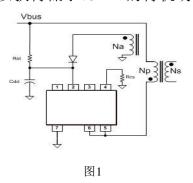
高度集成、离线式电流模式控制功率开关

7. 功能描述

JD3561是一款针对离线式反激电源设计的高性能功率开关,适用于电机驱动电源、电源适配器和通用开关电源应用中。

7.1 系统启动和工作电流

在芯片开始工作之前,JD3561仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值21V),JD3561开始工作并且芯片工作电流上升到1.2mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。当进入到打嗝模式后,芯片的工作电流将继续降低,由此可以获得低于75mW的待机功耗。



7.2 带有抖频功能的振荡器

在JD3561内部通过校准PWM开关频率被严格固定为65kHz。为了改善系统EMI性能,芯片自带 ±4%范围的抖频功能。

7.3 绿色节能工作模式

由于在轻载和空载状态下,系统的损耗主要来源于与开关频率成正比 的开关损耗,所以为了满足绿色节能的要求,有必要通过打嗝或者降低开 关频率的方式降低开关周期次数,以提高系统平均工作效率。



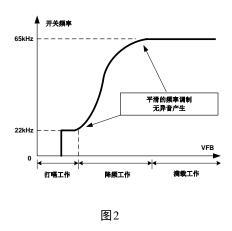
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

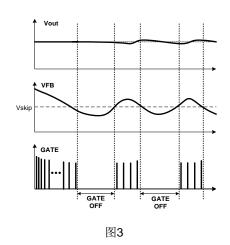
7.4 平滑的频率调制

在轻载状态下,JD3561采用了一种专利的"平滑的频率调制"技术调节开关频率。相比于其他频率调制设计,此技术可以平滑的调节开关频率而无异音产生。



7.5 打嗝模式

当负载非常小时,系统便进入到打嗝模式工作。当FB电压低于阈值 Vskip时,JD3561便停止开关动作而输出电压开始降低(如图3所示), 之后引起FB再次上升。一旦当FB电压 超过阈值Vskip时,芯片重新开始 开关动作。通过打嗝模式工作,降低了开关频率和待机状态下的系统功 耗。





ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

7.6 内部斜率补偿

对于传统的电流模式控制,如何避免在连续模式下当占空比超过50%时出现系统稳定性问题是关键。JD3561内部采用在采样电压信号上叠加斜率电压的方式实现斜率补偿,这样极大的增加了系统工作在连续模式下的稳定性,避免了次谐波振荡的产生和降低了输出电压纹波。

7.7 前沿消隐 (LEB)

由于原边MOSFET集成电容和副边输出二极管反向恢复的问题,当功率MOSFET开通瞬间在采样电阻上便产生一电压尖峰。为了避免GATE信号被错误关断,芯片内部集成有前沿消隐功能。在此时间内(典型值250ns),PWM比较器停止工作且GATE输出不允许关断。

7.8 过热保护(OTP)

当芯片结温超过165℃时,芯片停止工作,只有当结温低于140℃时, 芯片才能重新开始工作。

7.9 软启动

JD3561内部集成有典型值2ms的软启动功能,通过启动阶段逐周期增加过流保护阈此功能有利于避免变压器的饱和和降低副边二极管的应力。每次系统的重启都将伴随一次软启动过程。

7.10 恒功率控制

芯片采用了一种专利的"恒功率控制"技术实现全电压输入范围内 高精度恒功率输出。通过获取原边占空比信息,芯片利用特有的模拟方 式产生随占空比而改变的过流保护阈值。



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

7.11 过载保护

当过载发生且FB电压超过VTH_OLP持续时间超过75ms时,芯片便进入到过载保护模式并开始自动重启。75ms的保护延时有利于避免在开机过冲中错误保护。

7.12 VDD 过压保护(OVP)和箝位

当VDD电压超过31V(典型值)时,芯片停止开关动作。当VDD电压 开始下降并低于关断电压VDD_OFF (典型值9V),系统开始重新启动。 芯片内部集成35V(典型值)的箝位稳压管,有效地避免了芯片的损伤。

7.13 CS 管脚开路保护

当VDD电压超过开启电压VDD_ON(典型值21V)后,在开始开关动作之前首先检测CS管脚是否开路。如果CS管脚被检测为开路状态,则不允许开关动作并进入到自动重启模式;否则,系统开始正常工作。利用此种保护方式增强了系统的可靠性。

7.14 自动重启保护

如图4所示,一旦某种故障被检测到时,芯片立即停止开关动作,之后由于芯片无法通过辅助绕组供电而使得VDD电压下降。当VDD电压下降到关断电压VDD_OFF(典型值9V)时保护逻辑被复位且芯片工作电流同时降低至启动电流IVDD_st(典型值2uA),之后VDD电压再次重新上升。当VDD电压超过开启电压VDD_ON(典型值21V)时再次重新开关动作。如果故障仍然存在,那么系统将继续重复以上保护动作;否则系统恢复正常工作。依靠以上功能,系统可以针对性地开始和停止开关动作并直至故障消失。



ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

高度集成、离线式电流模式控制功率开关

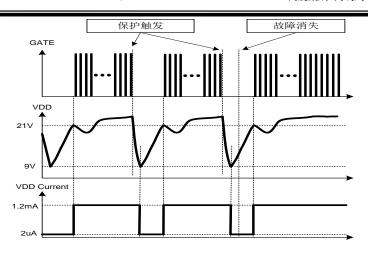


图 4

7.15 软驱动

JD3561的图腾驱动电路的输出级具有400mA的输出电流能力,有效降低了开通过程中的交越损耗、提高了效率和增强了系统的可靠性。内部设计有13V的MOSFET源极驱动电压箝位功能。同时,驱动电路设计有软驱动功能可有效地优化系统EMI。

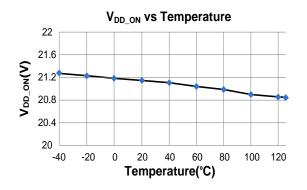


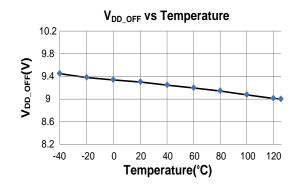
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

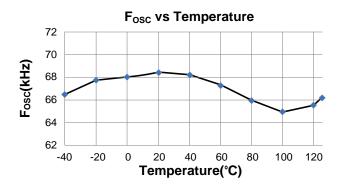
JD3561

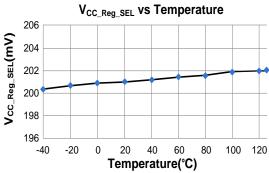
高度集成、离线式电流模式控制功率开关

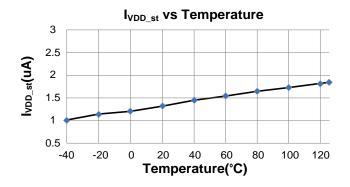
8. 参数特性曲线

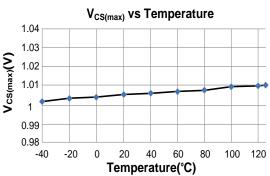














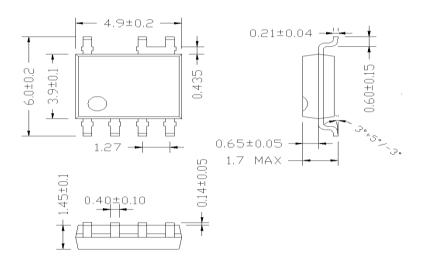
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

JD3561

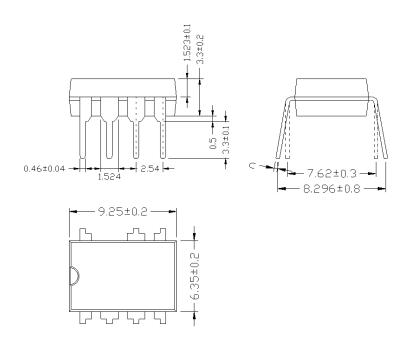
高度集成、离线式电流模式控制功率开关

9. 封装外形(单位: mm)

9.1 SOP-7



9.2 DIP-7



版本修改信息:

V1.0.....初始版本。

V1.1......... 部份产品型号调整、rdson 参数调整。

V1.2......增加 JD3561DF、JD3561DG。

V1.3........... 部份产品型号调整。

V2.0.....更改地址。